

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-284078

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和62年(1987)12月9日

C 23 C 16/40
16/44

6554-4K
6554-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 化学気相成長方法

⑯ 特 願 昭62-123906

⑰ 出 願 昭58(1983)5月14日

前実用新案出願日援用

⑱ 発 明 者	古 川	量 三	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号	沖電気工業株式会社内
⑱ 発 明 者	小 林	正 男	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号	沖電気工業株式会社内
⑱ 発 明 者	上 條	健	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号	沖電気工業株式会社内
⑱ 発 明 者	高 野	紘	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号	沖電気工業株式会社内
⑲ 出 願 人	沖電気工業株式会社			東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
⑳ 代 理 人	弁理士 角田 仁之助			

明 細 書

1. 発明の名称

化学気相成長方法

2. 特許請求の範囲

水平の石英板の中心下方に直立する第1ガス導入管の側面の複数の孔より原料ガスである酸素及びシランと輸送ガスであるアルゴン又は窒素とを噴出し、

前記第1ガス導入管を中心に有する穴に遊挿して水平に設けられた基板回転板の上面に、基板を置いて回転させ、

前記基板回転板の下に配置されたヒータにより前記基板を加熱し、

前記基板回転板の上方の半径方向に設けられた第2ガス導入管の側面の複数の孔より前記基板上に原料ガスであるジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛と輸送ガスであるアルゴン又は窒素を噴出してZnOとSiO₂との混成膜を形成することを特徴とする化学気相成長方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は複数のガス導入管を設けて、選択的にガスを噴出し基板上に混成膜を形成するようにした化学気相成長方法に関するものである。

(従来の技術)

基板上にZnOとSiO₂の混成膜を形成する従来の化学気相成長装置を第2図に示す。

第2図は従来の装置の主要部を説明する一部切断した斜視図である。図において1は基板回転石英板、2はガス導入管、3は石英板、4はヒータ、5は基板回転石英板1上に載置された基板、6は基板回転石英板1の回転方向を示している。

石英板3とその下方に距離をおいて平行に設けた中心に穴1-1を有する基板回転石英板1とその下に設けたヒータ4と該基板回転石英板1の中心の穴1-1に遊挿され、側面2-1に複数の噴出口2-2を有するガス導入管2とにより反応室が形成されていて、基板回転石英板1の上面に基板5を載置し、回転手段は図示していないが、回転

(1)

(2)

方向6に回転するとともにガス導入管2の側面2-1に設けられている複数の噴出孔2-2からそれまでの径路は図示していないが、原料ガスと輸送ガスが基板回転石英板1上の基板5上噴出されて、基板5上にZnOとSiO₂の混成膜が形成される。

原料ガスは酸素、シラン、ジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛であり、輸送ガスはアルゴン又は窒素であって、これらをガス導入管2により導入手段の図示は省略したが導入し、原料ガスのシラン、ジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛は基板回転石英板1上で熱分解し、酸化し、基板回転石英板1に載置された基板5上にZnOとSiO₂の混成膜が形成される。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら従来技術においては、基板回転石英板1は矢印6方向に回転させてガス導入管2を中心に基板5は公転するが、ジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛は酸素と激しく反応するため、ガス導入管2内及びその附近で原料の大部分が反応し、シランガスは、ジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛に

(3)

板上に原料ガスであるジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛と輸送ガスであるアルゴン又は窒素を噴出させることによりZnOとSiO₂との混成膜を成長させるように構成したものである。

(作用)

基板上にZnOとSiO₂との混成膜を化学気相成長する方法を前記の通り構成し酸素との反応の激しいジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛は酸素と別々に基板上に導入され均一性のあるZnOとSiO₂の混成膜を得ることができるのである。

(実施例)

本発明の一実施例を図面とともに説明する。

第1図は本発明の一実施例による化学気相成長装置を示す斜視図であって、該装置の主要部を説明するため一部切断してある。

15は第2ガス導入管、15-1は横架部分、15-2はガス噴出口である。第2図と同じ部分は同じ符号をつけてある。

第1図に示すように石英板3と、その中心下方に直立する第1ガス導入管2と、石英板3の下方

(5)

比べて、酸素との反応は遅いのでZnOとSiO₂混成膜内のZnOとSiO₂との混成比は、回転半径方向に対して、不均一となり、又混成膜中のZnOの割合が非常に小さくなるような欠点があった。

本発明の目的はこれらの欠点を除去するため酸素との反応の激しいジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛を酸素と別々に基板上に導入して、均一性のあるZnOとSiO₂の混成膜を得る化学気相成長方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

本発明はZnOとSiO₂との混成膜を化学気相成長させるに際し、水平の石英板の中心下方に直立する第1ガス導入管の側面の複数の孔より原料ガスである酸素及びシランと輸送ガスであるアルゴン又は窒素とを噴出し、前記第1ガス導入管を中心に有する穴に遊挿して水平に設けられた基板回転板の上面に、基板を置いて回転させ、前記基板回転板の下に配置されたヒータにより前記基板を加熱し、前記基板回転板の上方の半径方向に設けられた第2ガス導入管の側面の複数の孔より前記基

(4)

に水平に設けられておりその中心の穴1-1に第1ガス導入管2が遊挿されていて、図示されていないが、回転装置によって第1ガス導入管2を中心として回転方向6に回転されるようになってい基板回転石英板1とその下に配置されたヒータ4と基板回転石英板1の上方で下面に複数のガス噴出孔15-2を有し半径方向に横架するように設けられた部分15-1からなる第2ガス導入管とにより反応室を形成する。つぎにこの発明のZnOとSiO₂との混成膜の成長方法を説明する。

ガス導入の経路は図示していないが、第1ガス導入管2の噴出孔2-2より原料ガスとして酸素、シラン、及び輸送ガスとしてアルゴン又は窒素を導入し、第2ガス導入管15の噴出孔15-2より原料ガスとしてジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛及び輸送ガスとして同じようにアルゴン又は窒素を基板回転石英板1の上面に直接あたるように噴出する。原料ガスのシラン、ジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛は、基板回転石英板1上で混合し、熱分解し、酸化し、基板回転石英板1の上におかれた

(6)

基板 5 上に ZnO と SiO_2 の混成膜が形成される。基板回転石英板 1 は矢印 6 の方向に回転させてあるので基板 5 は第 1 ガス導入管を中心にして公転する。酸素との反応の激しいジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛と酸素とを別々の導入管より反応室内に導入するようにしたので、導入途中でのジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛と酸素の反応は防止され、基板回転石英板 1 におかれた基板 5 上に ZnO と SiO_2 の混成膜が形成される。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、酸素との反応の激しいジメチル亜鉛又はジエチル亜鉛を酸素とちがった第 2 ガス導入管で反応室内に導入し、直接基板にあたるように噴出するから基板上に形成される ZnO と SiO_2 の混成膜内の ZnO と SiO_2 の混成比は回転半径方向に対して不均一とならず、混成膜内の均一性を保持できるばかりでなく、混成膜中の ZnO の割合を大きくできるという利点があり、均一性混成比の選択性にすぐれているので良質な ZnO と SiO_2 の混成膜の形成に利用できると

(7)

いう効果がある。

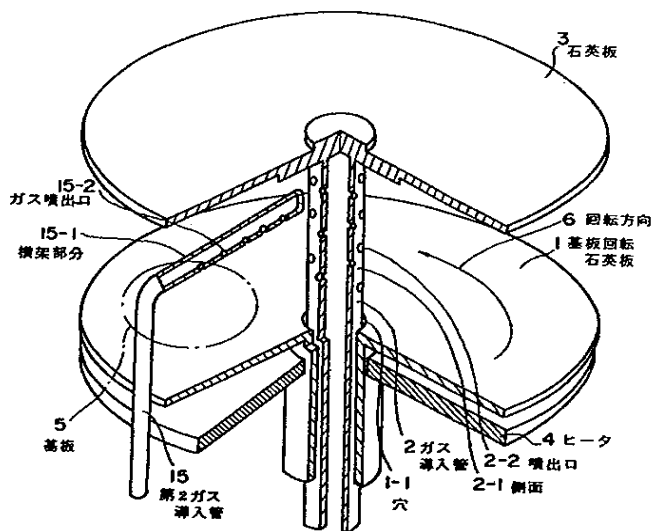
4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の一実施例による化学気相成長装置を示す一部切断斜視図、第 2 図は従来の化学気相成長装置の一部切断した主要部斜視図である。

1…基板回転石英板、1-1…穴、2…ガス導入管、2-1…側面、2-2…ガス噴出口、3…石英板、4…ヒータ、5…基板、6…回転方向、15…第 2 ガス導入管、15-1…横架部分、15-2…ガス噴出口。

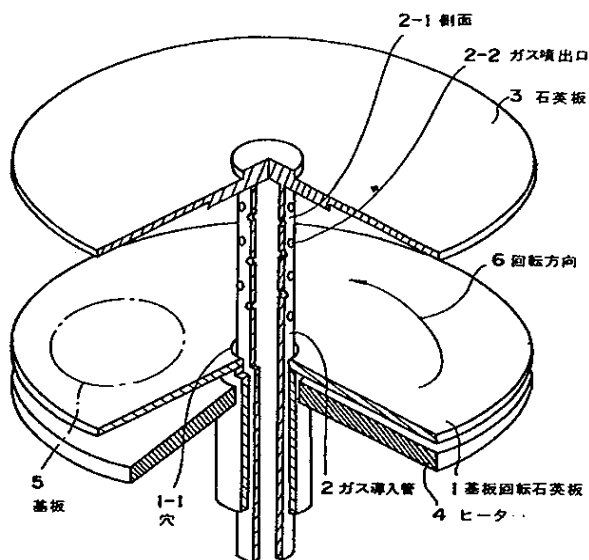
特許出願人 沖電気工業株式会社

代理人 角 田 仁 之 助



本発明の一実施例による化学気相成長装置を示す一部切断斜視図

第 1 図



従来の化学気相成長装置の一部切断した主要部斜視図

第 2 図